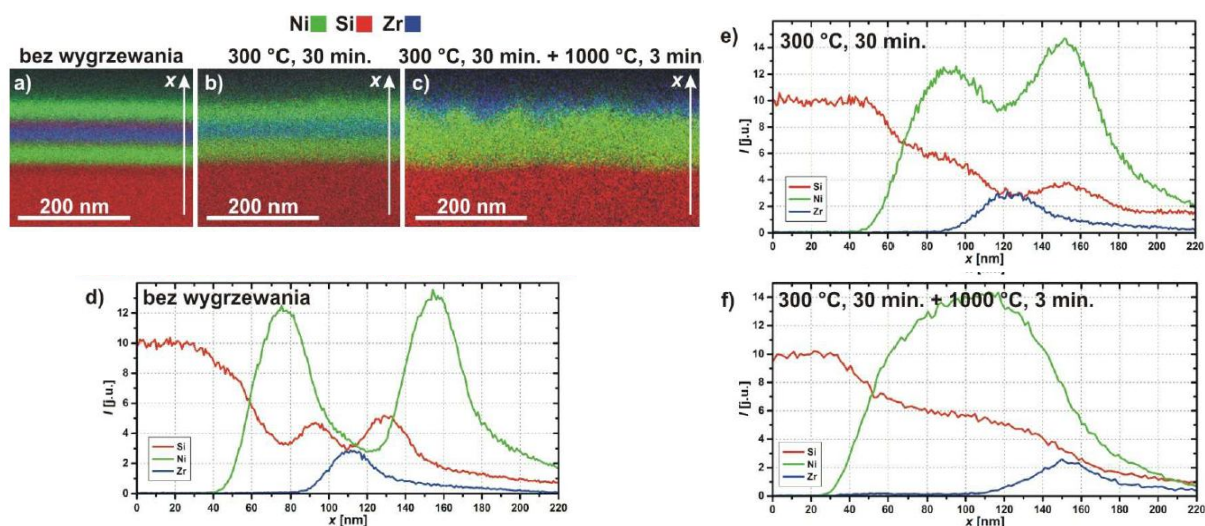


Opatentowana sekwencja wytwarzania ulepszonych kontaktów omowych do SiC

Na podstawie wnikliwych badań elektronmikroskopowych opracowano i opatentowano sekwencję technologiczną dla otrzymania ulepszonych kontaktów omowych do SiC, wykorzystującą amorficzną warstwę Ni-Zr podczas pierwszego etapu wygrzewania. Zastosowanie tej metody przyniosło wyraźną poprawę mikrostruktury kontaktów (skutkującą lepszą niezawodnością), bardzo dobrą ich rezystywność (nawet poniżej $2 \times 10^{-6} \Omega \text{cm}^2$) i stabilność termiczną.



Rys. Wyniki analizy XEDS dla struktur Ni/Si/Zr/Si/Ni/Si/4H-SiC po kolejnych etapach operacji termicznych: mapy i wykresy koncentracji Ni, Si i Zr w głąb struktury